

項目	記号	説明		
絶対最大定格	絶対最大定格	—	瞬時といえども超えてはならない最大値 特に指定のない場合は $T_a=25^{\circ}\text{C}$ における値です。	
	入力側	LED順電流	I_F	連続的にLED順方向に流し得る電流定格
		繰り返しピークLED順電流	I_{FP}	瞬時的にLED順方向に流し得る電流定格
		直流順電流低減率	$\Delta I_F/\text{C}$	周囲温度とともにLED順方向に流し得る電流の低減率
		LED逆電圧	V_R	カソード・アノード間に印加し得る逆電圧定格
		接合部温度	T_j	LEDのジャンクション部で許容し得る温度定格
	出力側	負荷電圧	V_{OFF}	負荷の開閉やオフ状態でリレー出力端子間に印加し得る電圧定格 交流の場合はピーク電圧
		連続負荷電流	I_O	規定の温度条件のもと、オン状態でリレー出力端子間に流し得る電流定格 交流の場合はピーク電流
		オン電流低減率	$\Delta I_O/\text{C}$	周囲温度とともにオン状態でリレー出力端子間に流し得る電流の低減率
		パルスオン電流	I_{OP}	オン状態でリレー出力端子間に瞬時的に流し得る電流定格
		接合部温度	T_j	受光回路部のジャンクション部で許容し得る温度定格
	入出力間耐電圧	V_{LO}	入力・出力間の絶縁耐量を保証する電圧	
	使用周囲温度	T_a	リレーの機能を損なうことなく動作させ得る周囲温度範囲	
	保管温度	T_{stg}	リレーに電圧を印加しない状態で保存し得る周囲温度範囲	
	はんだ付け温度条件	—	リレーの機能を損なうことなく端子をはんだ付けするための温度定格	
電気的性能	入力側	LED順電圧	V_F	規定の順電流値でのLEDアノード・カソード間電圧降下
		逆電流	I_R	LED逆方向(カソード・アノード間)に流れる漏れ電流
		端子間容量	C_T	LEDアノード端子・カソード端子間の静電容量
		トリガLED順電流	—	リレーの出力状態を遷移するための入力電流の最小値。 リレーを確実に動作させるためには最大規格以上の電流で使用する必要があります。
			I_{FT}	a接点タイプの出力MOS FETをオン状態へ移行させるに必要な入力電流 I_F の最小値
	I_{FC}		b接点タイプの出力MOS FETをオフ状態へ移行させるに必要な入力電流 I_F の最小値	
	復帰LED順電流	—	リレーの出力状態を復帰させるための入力電流の最大値。 リレーを確実に復帰させるためには最小規格以下の電流にする必要があります。	
		I_{FC}	a接点タイプの出力MOS FETをオフ状態へ復帰させるために流せる入力電流 I_F の最大値	
		I_{FT}	b接点タイプの出力MOS FETをオン状態へ復帰させるために流せる入力電流 I_F の最大値	
	出力側	最大出力オン抵抗	R_{ON}	規定のオン状態におけるリレー出力端子間の抵抗値
		開路時漏れ電流	I_{Leak}	オフ状態でリレー出力端子間に規定の電圧を印加した際に流れる漏れ電流
		端子間容量	C_{OFF}	規定のオフ状態におけるリレー出力端子間の静電容量
		リミット電流	I_{LIM}	カレントリミット機能が働いた際に保持される負荷電流値
		入出力間容量	C_{LO}	入力端子—出力端子間の静電容量
	入出力間容量絶縁抵抗	R_{LO}	入力端子—出力端子間に規定の電圧を印加した際の抵抗値	
動作時間	t_{ON}	規定の入力LED電流を印加してから出力波形が遷移するのに要する時間 a接点タイプ: 入力オフ→オン時点から出力波形が100%から10%まで遷移するのに要する時間 b接点タイプ: 入力オン→オフ時点から出力波形が100%から10%まで遷移するのに要する時間		
復帰時間	t_{OFF}	規定の入力LED電流を遮断してから出力波形が遷移するのに要する時間 a接点タイプ: 入力オン→オフ時点から出力波形が0%から90%まで遷移するのに要する時間 b接点タイプ: 入力オフ→オン時点から出力波形が0%から90%まで遷移するのに要する時間		
等価立上り時間	ERT	高速信号やパルス信号に対する出力側の通過特性の指標 入力波形の立上り時間 tr_{in} 、リレーを通過した出力波形の立上り時間 tr_{out} として次の式で表され、 値が小さいほど信号の変化が少ないため良い特性とされます。 $ERT = \sqrt{(tr_{out}^2 - tr_{in}^2)}$		
推奨動作条件	推奨動作条件	—	高い信頼度でご使用いただくため、最大定格・電気的性能に対してディレーティングを考慮した指標。 各項目は独立した条件であり、複合条件を同時に満たすものではありません。	
	負荷電圧	V_{DD}	ディレーティングを考慮した負荷電圧の推奨条件 交流の場合はピーク電圧	
	動作LED順電流	I_F	ディレーティングを考慮したLED順電流の推奨条件	
	連続負荷電流	I_O	ディレーティングを考慮した負荷電流の推奨条件 交流の場合はピーク電流	
	動作温度	T_a	ディレーティングを考慮した使用周囲温度の推奨条件	
参考データ	MOS FETオン電圧	V_{ON}	出力MOS FETのオン状態における出力端子間の電圧降下	
	相対出力端子間容量	$C_{OFF}/C_{OFF}(0V)$	出力端子間電圧が0Vでの出力側端子間容量を基準とした相対比	
その他	カレントリミット機能	—	過電流がある値以上に達すると、負荷電流をリミット電流特性の最小最大の間の一定値に保つ機能。 電流を一定値で抑えることで、リレーおよびリレー以降に接続されている回路部品を保護します。	
	低C×R	—	高周波信号や高速信号などを扱う用途での出力側の特性の指標。 Cはオフ状態の出力側端子間容量 C_{OFF} を、Rはオン状態の出力側端子間抵抗 R_{ON} を指します。 C_{OFF} が大きいとリレーがオフ状態でも信号が通過(信号漏れ、アイソレーション低下)することや オン状態で信号の立上り時間の遅れ(波形のなまり)に、 R_{ON} が大きいと信号の通過損失(電圧降下、インサクションロス低下)に影響します。このような用途では C_{OFF} が小さく、かつ R_{ON} が小さい 低C×R特性が重要となります。	